

【施設供用募集対象装置の設備仕様】

No.	設備・装置の種類	装置の概要・条件	担当者・連絡先	備考
1	J-KAREN-レーザー装置	<p>極短パルス・超高強度レーザー</p> <p>1)パワーアンプモード 中心波長: 810 nm パルスエネルギー: ~1 J パルス幅: 30~50fs 繰り返し: 10 Hz (1Hz、シングルショットも可能)</p> <p>2)ブースターアンプモード 中心波長: 810 nm ターゲット照射エネルギー: ~20 J パルス幅: 30~50fs 繰り返し:10秒/shot (シングルショットも可能)</p> <p>3)プラズマミラーモード コントラスト:ブースターアンプモードより3桁改善</p>	<p style="text-align: center;">宮坂泰弘 TEL:0774-80-8706</p>	<p style="text-align: center;">(木津) 実験棟 C103号室</p>
2	kHzチタンサファイアレーザー	<p>高繰り返しレーザー</p> <p>波長:800nm パルスエネルギー:2mJ パルス幅:50fs 繰り返し:1kHz</p>	<p style="text-align: center;">遠藤友随 TEL:0774-80-8903</p>	<p style="text-align: center;">(木津) 実験棟 C102号室</p>
3	X線回折装置	<p>X線回折装置(リガク:SLX2000)</p> <p>1)ターゲット:Cu (真空封止型(最大3kW))</p> <p>2)高精度ゴニオメータ搭載</p> <p>3)小角X線散乱測定による多層膜等の薄膜評価</p> <p>4)各種解析ソフト搭載(GXRR等)</p> <p>成膜装置(株大阪真空)</p> <p>1)ターゲット数:4元(5インチ角)</p> <p>2)成膜プロセス:シーケンサによる自動成膜(手動も可)</p> <p>3)膜厚制御法:シャッターによる時間制御(分解能0.1s)</p> <p>4)基板:050mm×12mmt(最大)、2個、自公転式</p>	<p style="text-align: center;">圓山桃子 TEL:0774-80-4332</p>	<p style="text-align: center;">(木津) 実験棟 C128号室</p>
4	QUADRA-レーザーシステム	<p>QUADRA-レーザーシステム</p> <p>波長:1030nm パルスエネルギー:20mJ パルス幅:1ps 繰り返し:5kHz</p>	<p style="text-align: center;">石井順久 TEL:0774-80-8873</p>	<p style="text-align: center;">(木津) 実験棟 C102号室</p>
5	集束イオンビーム加工観察装置	<p>集束イオンビーム加工観察装置 (日本電子 JIB-4000PLUS)</p> <p>イオン源: Ga液体金属イオン源 加速電圧: 30kV(最大) ビーム電流: 90 nA(最大) 倍率: x300,000(最大) デポジション材料: カーボン、タングステン</p>	<p style="text-align: center;">今亮 TEL:0774-80-8769</p>	<p style="text-align: center;">(木津) 実験棟 C215号室</p>